パイェルス系のソリトンと電子間相互作用

山口大理 原 純一郎 物性研 福山 秀敏 中野 隆

Su, Schrieffer と Heeger (SSH) がポリアセチレンにおけるソリトンの存在を提唱して以来,1次元電子-格子系のソリトンについて後々の研究がなされて来た。 しかしながらそれらの研究は,電子間の相互作用がない場合^{17~77}が,又は,電子間の相互作用が斥力で強い極限の場合⁸⁷に限られていた。 ここでは,電子間の相互作用を考慮に入れ、冷あるいは沿っまったバンドを持つ電子-格子系のソリトンについて議論する。

(1) ねっまったバンドの場合

SSHのハミルトニアンに電子向の相互作用を付け加えたものを、系のハミルトニアンとしょう。 電子向の相互作用が十分弱いとし、電子場をポツン表示 9),10)すると、ハミルトニアンは、

$$H = \int dx \left[A_{P}(\nabla \Theta)^{2} + A_{\sigma}(\nabla \Phi)^{2} + C_{P}P^{2} + C_{\sigma}M^{2} + B_{P}\cos 2\Theta + B_{\sigma}\cos 2\Phi - 2gu\cos \Theta\cos \Phi + Ku^{2} \right]$$
(1)

となる。 ここで,Oと中は電子場のポツン表示の際に導入された位相の演算子であり,局所的な電荷密度 P(x) とスピン密度 m(x)とは、

$$P(x) = \frac{1}{\pi} \nabla \Theta(x) , \qquad m(x) = \frac{1}{2\pi} \nabla \phi(x)$$
 (2)

の関係で結けれている。 ヌ,PとMはそれぞれOと中に正準共役な演算子である。 U(x) は格子のひずみを表し、3とKはそれぞれ電子一格 子相互作用の結合定数と弾性定数である。 A_P , A_G , C_P g W C_G は、電子 B の相互作用の強さに依存する定数であり $^{(1)}$, $^{(2)}$, 電子 B の相互作用のない時は、 $A_P = A_G = V_F$ /W 、 $C_P = C_G = \nabla V_F$ (V_F は V_F V_F) である。 一方 B_P と B_G は、電子 B 相互作用の B_P く D_G D_G

$$A_{\rho} \Delta O + B_{\rho} \sin 2\theta - gu \sin \Theta \cos \phi = 0 , \qquad (3)$$

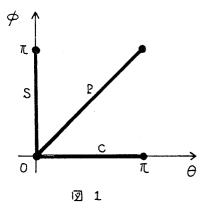
$$Ku - g \cos \phi \cos \phi = 0 \tag{5}$$

の解として手もられ、基府状態は、O(x)、中(x)とも場所×に依存せず、(O、中)=(mx、nx)である(図1.の黒真に対応)。 局所的励起状態であるソリトンは、 X→±∞ にかいて (O、中)→ (mx、nx)となるので、その軌跡をO-中平面に投影すると、図1.の様に基府状態の向を結ぶ曲線として表される。②式より、道線Sは、スピンS=±½、電荷Q=○の中性ソリトン、直線Cは、S=○

Q = ±eの電荷ソリトンに対応している事がわかる。 生成エネルギー は、

$$E_S = 4 \int A_{\sigma} \left(\frac{3!}{K} - 2B_{\sigma} \right)$$
, $E_c = 4 \int A_{\rho} \left(\frac{3!}{K} - 2B_{\rho} \right)$

となり電子向相互作用により、中世ソりトンと電荷ソりトンの生成エネルヤーに差が生じ得る事をふしている。 直線Pは、Ao=Ap=A、Bo=Bp=Bの場合のポーラロン(S=±1/2、Q=Te)を表しており生成エネルヤーは、



$$E_{p} = 2 \sqrt{2A \left(\frac{3^{2}}{K} - 4B\right)} \times \left[\sqrt{\lambda^{2} + 1} + \frac{1}{\lambda} \ln |\lambda + \sqrt{\lambda^{2} + 1}| \right]$$

である($\lambda=\sqrt{3^2/(3^2-4BK)}$)。 この状態は,一般には(つまり A_{σ} + A_{P} , B_{σ} + B_{P}) 直線 P から ずれ,トポロジカルにも電子 間相互作用の ない時の ポーラロンと 違ってくる。

(2) 均っまったバンドの場合

この場合のハミルトニアンを古典近似で書くと,

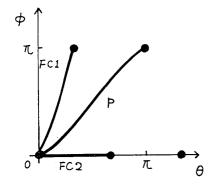
$$E_{3} = \int dx \left[A_{\rho} (\nabla \Theta)^{2} + A_{\sigma} (\nabla \Phi)^{2} + 2gu \sin(\Theta - \Theta_{Ph}) \cos \Phi + \widehat{g} u^{2} \cos \Phi \cos(\Theta + 2\Theta_{Ph}) + Ku^{2} \right]$$
(6)

となる。 ここで、Ophは Uskr = UsePiOph により定義されている(Uskr は 格子のひずりの内、波数 2kr (krはフェルミ波数)を持っ成分である)。 まは、電子一格子のウムクラップ過程の結合定数である。 UとOphの 做小変化に対して状態が安定である為の条件(つまり SE3/SU = O, SE3/SOph = O)を使って、Oと中に対する有効ハミルトニアムを導くと、

$$E_{3}(\Theta, \Phi) = \int dX \left[A_{e}(V\Theta)^{2} + A_{\sigma}(V\Phi)^{2} - \frac{9^{2}}{K} \frac{\cos^{2}\Phi}{1 - \alpha^{2}\cos^{2}\Phi} \left(1 + \alpha \cos\Phi\cos 3\Theta \right) \right]$$
 (7)

となる(X=3/K く1)。 基府状態は,O(x), $\Phi(x)$ とも場所 X にょらず, $O-\Phi$ 平面 での位置は,図2.の黒臭により示されている通りである。 この系のソットンも,やけり基府状態を結ぶ曲線により表される。 図2 の直線 FC2 は S=O $Q=\mp2e/3$ を持っソットン,曲線 FC1 は $S=\pm \frac{1}{2}$, $Q=\mp e/3$ のソットン,でして曲線

Pは、*- ラロン($S=\pm\frac{1}{2}$ 、 $Q=\mp e$)を表している(曲線 FC1 ϵ P は 模式的なものである)。 これらは Su ϵ Schrietter により見出された状態に対応しているか、S=0 、 $Q=\pm 4/8$ を持っソットンは、我々のモテルでは見っからなかった。



Ø 2

文献

- 1) W.P. Su, J.R. Schrieffer and A.J. Heeger: Phys. Rev. Lett. <u>42</u> (1979) 1698, Phys. Rev. <u>B22</u> (1980)
- 2) W. P. Su and J. R. Schrieffer: Phys. Rev. Lett. <u>46</u> (1981) 738.

- 3) M. J. Rice: Phys. Lett. 71A (1979) 152.
- 4) S. Brazovskii : Zh. Ekspa, and Teor. 78 (1980) 677.
- 5) H. Takayana , Y. R. Lin-Liu and K. Maki : Phys. Rev. <u>B21</u> (1980) 2388.
- 6) B. Horovitz: Phys. Rev. Lett. 46 (1981) 792.
- 7) S. Brazovskii and N. Kirova: preprint.
- 8) T. Nakano and H. Fukuyama : J. Phys. Soc. Jpn. 19 (1980) 1679.
- 9) A. Luther and I. Peschel: Phys. Rev. <u>B9</u> (1974) 2911.
- 10) A. Luther and V. J. Emery : Phys. Rev. Lett. 33 (1975) 589.
- 11) Y. Juzumura: Prog. Theor. Phys. <u>61</u> (1979) 1.
- 12) K. Takano, T. Nakano and H. Fukuyama: J. Phys. Soc. Jpn (in press).